



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 196 40 800 A 1**

⑳ Aktenzeichen: 196 40 800.8
㉑ Anmeldetag: 2. 10. 96
㉒ Offenlegungstag: 16. 4. 98

㉓ Int. Cl.⁶:
C 03 C 17/36
C 03 C 17/245
C 03 C 17/09
C 23 C 28/00
C 23 C 30/00
F 16 L 59/00

DE 196 40 800 A 1

㉔ **Anmelder:**

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE;
arcon-Flachglasveredlungsgesellschaft mbH & Co
Beschichtungstechnik KG, 91555 Feuchtwangen,
DE

㉕ **Erfinder:**

Schneider, Siegfried, 01445 Radebeul, DE; Hartung,
Ullrich, Dr., 01129 Dresden, DE; Kirchhoff, Volker,
01324 Dresden, DE; Söder, Bernhard, Dr., 91639
Wolframs-Eschenbach, DE; Meier, Andreas, 72793
Pfullingen, DE

㉖ **Entgegenhaltungen:**

DE 39 41 027 A1
DE 39 41 026 A1
DE 3 8 86 47 4T2
EP 03 03 109 A2
WO 93 20 256 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉗ **Wärmedämmendes Schichtsystem für transparente Substrate**

㉘ Die bekannten Schichtsysteme bestehen im wesentli-
chen aus einer Metalloxidschicht, Silberschicht als Refle-
xionsschicht, Blockerschicht und Metalloxidschicht. Es
werden die verschiedensten Metalle oder deren Oxide
verwendet. Nachteilig ist, daß derartige Schichtsysteme
gegen äußere Einflüsse sehr empfindlich, unzureichend
haftfest und ungenügend temperaturbelastbar sind.
Erfindungsgemäß ist auf einer Grundsicht und darauf
befindlicher Reflexionsschicht und darüber aufgebracht
Blockerschicht eine dielektrische Zwischenschicht aus
dem Metall der Blockerschicht aufgebracht. Auf der Zwi-
schenschicht befindet sich eine dielektrische Deckschicht
aus einem anderen Metall als die Blockerschicht. Die di-
elektrische Zwischen- und Deckschicht kann eine Oxid-,
Nitrid- oder Oxinitridschicht sein.
Das Anwendungsgebiet ist die Verglasung von Gebäuden
und Fahrzeugen.

DE 196 40 800 A 1

Die Erfindung betrifft ein wärmedämmendes Schichtsystem für transparente Substrate, vorzugsweise Glas, welches eine hohe Transmission im sichtbaren und eine hohe Reflexion im infraroten Wellenlängenbereich, d. h. eine hohe Selektivität besitzt. Verglasungen mit derartigen Schichtsystemen haben die Eigenschaft, daß sie einen möglichst großen Teil der solaren Energieeinstrahlung in die damit verglasten Räume hindurch lassen und einen möglichst hohen Anteil der wesentlich niederenergetischen Raumtemperaturstrahlung reflektieren. Sie lassen nur den sichtbaren Anteil des Sonnenspektrums passieren und reflektieren fast vollständig alle Strahlung mit größerer Wellenlänge. Die einzelnen Schichten werden durch Vakuumbeschichtung, insbesondere Sputtern, aufgebracht.

Bekannt sind wärmedämmende Schichtsysteme mit der Schichtfolge Metalloxid 1 (Me1O) – Ag-Blocker – Metalloxid 2 (Me2O), wobei anstelle von Ag auch Au oder Cu verwendet wird. Die meist verwendeten Blockerschichten bestehen beispielsweise aus wenige nm dicken Metallschichten, wie Al, CrNi, Ti oder Ta und schützen das Ag vor Oxidation beim reaktiven Aufbringen der Me2O-Schicht, indem der zunächst metallisch abgeschiedene Blocker aufoxidiert wird. Die MeO-Schichten entspiegeln das Schichtsystem und bestimmen die Reflexionsfarbe. Typisch sind Oxide der Metalle Sn, Zn, Bi, Ti oder deren Gemische. Die Me1O- und die Me2O-Schichten können aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien bestehen. Außerdem kann eine oder können beide dieser Me1O-Schichten auch aus mehreren übereinanderliegenden, unterschiedlichen MeO-Schichten aufgebaut sein (DE 39 41 026 A1; DE 39 41 027 A1).

Derartige Schichtsysteme haben den Nachteil, daß sie gegen äußere Einflüsse empfindlich sind, und die Haftfestigkeit des Schichtsystems unzureichend ist.

Es ist auch bekannt, Schichtsysteme mit noch höherer Selektivität herzustellen, deren Schichtsystem aus zwei Ag-Schichten mit der Schichtfolge Me1O – Ag-Blocker – Me2O – Ag-Blocker – Me3O bestehen (EP 0 632 849). Diese auf dem Flachglas aufgetragenen Schichtsysteme sind bis zum Herstellen des Scheibenverbundes relativ empfindlich gegen Schäden durch atmosphärische Einflüsse. Ein weiterer Nachteil ist es, daß sie nicht temperaturbelastbar sind.

Es ist weiterhin bekannt, temperaturbelastbare Schichtsysteme herzustellen, die ein Biegen und/oder Härten zulassen. Bei diesen Schichtsystemen ist jeweils eine Blockerschicht ober- und unterhalb der Ag-Schicht angeordnet, um diese gegen Oxidation und Diffusion bei der Wärmebehandlung zu schützen (EP 0 303 109). Auch diese Schichtsysteme haben den Nachteil, daß sie relativ empfindlich gegen Schäden durch atmosphärische Einflüsse sind.

Um gleichzeitig einen guten Schutz gegen Schäden durch atmosphärische Einflüsse während der Lagerzeit bis zum Herstellen eines Scheibenverbundes zu erhalten, ist es bekannt, auf die Blockerschicht weitere Oxidschichten in der Reihenfolge von Oxiden eines Metalles 2 – eines Metalles 1 – eines Metalles 2 aufzubringen (DE 38 86 474 T2). Jedoch besteht der Nachteil, daß infolge der geringen Schichtdicke der Metall-1-oxidschicht eine freie Einstellung der optischen Werte bei diesem Schichtsystem nicht möglich ist. Es sind nur geringe Variationen für die Einzelschichtdicken möglich, um die gewünschten Effekte zu erhalten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein wärmedämmendes Schichtsystem für transparente Substrate zu schaffen, das eine möglichst hohe Selektivität besitzt. Gleichzeitig soll dieses Schichtsystem eine möglichst stö-

rungsfreie Weiterverarbeitung bis zum Scheibenverbund ermöglichen, das heißt, daß es eine hohe Beständigkeit gegen Schäden durch atmosphärische Einflüsse haben soll. Das Schichtsystem soll unempfindlich sein gegen Handhabungsfehler, wie z. B. Abrieb. Die optischen Werte sollen frei einstellbar sein. Weiterhin soll das Schichtsystem temperaturbelastbar und die Herstellung des Schichtsystems ökonomisch in bekannten Anlagen zur Vakuumbeschichtung – insbesondere durch Aufstäuben – möglich sein.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe nach den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind in den Unteransprüchen 2 bis 6 beschrieben.

Es wurde gefunden, daß bei gleicher Ag-Schichtdicke eine höhere IR-Reflexion erreicht wird, wenn auf die metallisch aufgestäubte Blockerschicht unmittelbar anschließend reaktiv mit einer Mindestdicke von 5 bis 20 nm eine erste Oxid- bzw. Nitridschicht aus dem gleichen Metall wie das der Blockerschicht und darauf eine weitere Oxid- bzw. Nitridschicht eines anderen Metalles wie das der Blockerschicht gestäubt wird. Die Schichtdicken dieser beiden dielektrischen Schichten können frei so gewählt werden, daß sowohl die Selektivität hoch ist als auch die Reflexionsfarben in weiten Grenzen optimiert werden können. Die beiden unterschiedlichen dielektrischen Schichten können auch ein- oder mehrfach wiederholt aufgebracht werden. Bei Verwendung von Ti als Blockerschicht und TiO₂ als erste Oxidschicht auf der Blockerschicht wird dieser Effekt besonders deutlich, denn überraschenderweise werden höhere Werte der Selektivität als allgemein üblich erreicht.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, daß dabei gleichzeitig die Festigkeit des gesamten Schichtsystems gegenüber den bekannten Schichtsystemen um etwa den Faktor 2 verbessert und der Schutz gegen Schäden durch atmosphärische Einflüsse noch weiter erhöht wird.

Das Erfindungswesentliche ist das auf der Reflexionschicht aufgetragene Teilschichtsystem aus der Blockerschicht, dielektrischer Zwischenschicht und dielektrischer Deckschicht. Die beiden letztgenannten Schichten können sowohl Oxid-, Nitrid- oder Oxinitridschichten sein. Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, wird aber nur gelöst, wenn das Metall für die dielektrische Zwischenschicht das Material der Blockerschicht ist, und das Metall für die dielektrische Deckschicht ein anderes Metall als das der Zwischenschicht ist.

Vorteilhaft ist es, wenn bei der Herstellung der ersten dielektrischen Schicht der Arbeitspunkt der reaktiven Zerstäubung derart eingestellt wird, daß leicht überstöchiometrische Schichten abgeschieden werden. Um eine gezielte Stöchiometrie einstellen zu können, kann die Regelung des Reaktivgaseinlasses auf eine konstante Plasmaemission oder auf eine konstante Brennschmelze erfolgen. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Zwischen- und/oder Deckschicht mit Hilfe des reaktiven Mittelfrequenzsputterns hergestellt wird.

Bei Anordnung von Blockerschichten beiderseits der Ag-Schicht lassen sich derartig beschichtete Scheiben auch biegen oder härten.

An zwei Ausführungsbeispielen wird die Erfindung näher beschrieben.

Es ist ein erfindungsgemäßes Schichtsystem auf eine Flachglasscheibe von 4 mm Dicke mit folgendem Schichtaufbau aufgebracht:

Glassubstrat
ZnO (35 nm) oxidische Grundsicht
Ag (15 nm) Reflexionsschicht
Ti (3 nm) Blockerschicht
TiO₂ (21 nm) oxidische Zwischenschicht
ZnO₂ (26 nm) oxidische Deckschicht

Die optische Ausmessung dieses Schichtsystems zeigte, daß gegenüber einem optisch optimierten Schichtsystem nach dem Stand der Technik, d. h. ohne die erfindungsgemäße TiO_2 -Zwischenschicht, die Reflexion im Infrarotbereich bei gleicher Schichtdicke der Reflexionsschicht aus Ag wesentlich höher ist. Die Andruckkraft der Prüfspitze im Abrasionstest bis zur ersten Beschädigung lag um den Faktor 2 höher.

Eine weitere Ausführungsform des Schichtsystems besteht darin, daß sich das Teilschichtsystem – wie im ersten Beispiel gezeigt – aus dielektrischer Zwischen- und Deckschicht auf der Blockerschicht noch einmal wiederholt. Das Schichtsystem ist dabei wie folgt aufgebaut:

Glassubstrat
 ZnO (35 nm) oxidische Grundschrift 15
 Ti (4 nm) Blocker
 Ag (15 nm) Reflexionsschicht
 Ti (5 nm) Blockerschicht
 TiO_2 (12 nm) oxidische Zwischenschicht
 SnO_2 (10 nm) oxidische Deckschicht 20
 TiO_2 (8 nm) oxidische Zwischenschicht
 SnO_2 (10 nm) oxidische Deckschicht

Nach der Beschichtung, wie im ersten Beispiel beschrieben, wurde das Glassubstrat mit dem darauf befindlichen Schichtsystem beim Erweichungspunkt des Glases gebogen und durch Anblasen mit kalter Luft gehärtet. Die optische Ausmessung zeigte, daß gegenüber einem optisch optimierten Schichtsystem nach dem Stand der Technik, d. h. ohne die erfindungsgemäße TiO_2 -Schicht, die Reflexion im Infrarotbereich bei gleicher Schichtdicke der Reflexionsschicht aus Ag wesentlich höher ist. Die Andruckkraft der Prüfspitze im Abrasionstest bis zur ersten Beschädigung lag um den Faktor 3 höher. Schäden durch atmosphärische Einflüsse während einer sechswöchigen freien Lagerung an Luft waren nicht zu erkennen. Demgegenüber zeigen die bekannten Schichtsysteme bereits nach vierwöchiger Lagerzeit erste Schäden.

Patentansprüche

1. Wärmedämmendes Schichtsystem für transparente Substrate, bestehend aus einer oder mehreren metallischen Reflexionsschichten, die auf einer auf dem Substrat aufgetragenen dielektrischen Grundschrift aufgebracht sind, einer auf der Reflexionsschicht oder auch zusätzlich unter ihr aufgetragenen metallischen Blockerschicht und einer über der auf der Reflexionsschicht aufgetragenen Blockerschicht aufgetragenen Zwischenschicht, **dadurch gekennzeichnet**, daß die auf der auf der Reflexionsschicht aufgetragenen Blockerschicht aufgetragene dielektrische Zwischenschicht mindestens 5 nm dick und ein Oxid, Nitrid oder Oxinitrid aus dem Metall der Blockerschicht ist, daß auf der dielektrischen Zwischenschicht eine dielektrische Deckschicht eines Oxids, Nitrids oder Oxinitrids eines anderen Metalls als das der Blockerschicht aufgebracht ist, und daß der Schichtverbund aus Zwischenschicht und Deckschicht mindestens einmal auf der Blockerschicht aufgebracht ist.
2. Wärmedämmendes Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall für die dielektrische Zwischenschicht Ti , Ta , Zr , Al oder Si oder ein Gemisch aus diesen Metallen ist.
3. Wärmedämmendes Schichtsystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall für die dielektrische Deckschicht Bi , Sn , Zn oder ein Gemisch aus diesen Metallen ist.
4. Wärmedämmendes Schichtsystem nach Anspruch 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrische Zwischenschicht 5 bis 25 nm dick ist.

5. Wärmedämmendes Schichtsystem nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrische Deckschicht 5 bis 60 nm dick ist.

6. Wärmedämmendes Schichtsystem nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrische Zwischenschicht durch Regelung des Reaktivgases als eine leicht überstöchiometrische Schicht abgeschieden ist.

- Leerseite -